

Aslanova Əminə Rasim qızı

Bakı Dövlət Universiteti, Fiziki elektronika kafedrası
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: 99412 - 439-73-73

E-mail: aslanova78@yahoo.com



QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

10.VI.1978 – Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub və 1995 – ci ildə Bakı şəhəri, Nəsmi rayonu 19 nömrəli orta məktəbi bitiribdir. BDU-nun Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika ixtisası üzrə bakalavryat və bərk cisim elektronikasına ixtisası üzrə magistratura səviyyələrini “fərqlənmə” diplomu ilə bitiribdir. Elmi fəaliyyətini davam etdirərək, BDU-nun Fizika fakültəsinin Bərk cisimlər fizikası ixtisası üzrə əyani doktoranturasını bitirib, “Səthi potensial çəpərli metal – silisium keçidlərinin energetik strukturunun xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıbdir. Ailəlidir, iki oğlu vardır

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2016 – fizika üzrə fəlsəfə doktoru, “Bərk cisimlər fizikası”, Fizika fakültəsi, BDU

2004 - 2007 – doktorant, “Bərk cisimlər fizikası”, Fizika fakültəsi, BDU

2000 - 2002 – magistr, “Bərk cisimlər elektronikasına” ixtisası, Fizika fakültəsi, BDU

1996 - 2000 – bakalavr, “Fiziki elektronika” ixtisası, Fizika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007 – indiyə kimi müəllim, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Səthi potensial çəpərli kontakt hadisələri

Əlavə elektrik sahəli real metal-yarımkeçirici makro-, mikro- və nanokontaktlar fizikası.

Mühüm elmi nəticələri:

- Real metal – yarımkeçirici kontaktlarda (MYK) kontakt səthinin həm qeyri-bircinsliyi, həm də onu əhatə edən metal və yarımkeçiricinin sərbəst səthləri ilə məhdudlanması hesabına əlavə elektrik sahəsinin yaranması;
- Düzləndirici real MYK-ların həndəsi ölçü effekti və onların faktiki işlək energetik modelləri və cərəyanaxma mexanizmləri;
- Əlavə elektrik sahəli MYK əsasında Genəş elementləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2005, 2006, 2007, 2008 Ульяновск, Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы»

2006, 2008, 2010, 2012, Москва, XIX Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения

2006, Таганрог, IX Международная Научно-Техническая Конференция "Таганрог, "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники

2008, Turkey, Secand International Confrens Physics Techn. Energy

2015, Bakı, X Beynəlxalq elmi konfrans konfransının materialları

2016, 2017 Bakı, BMU, İternational Scientific conference of young researchers

2017, Bakı, “Fizikaya müasir baxış” Beynəlxalq konfransı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Асланова А.Р. Температурные особенности параметров кремниевых поверхностно-барьерных диодов // Труды VII Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы», Ульяновск, 2005, с.79
2. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Зависимость коэффициента неидеальности от высоты барьера диода Шоттки // Тезис докл. XIX Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения Москва, 2006, с.206-207
3. Асланова А.Р. Кажущий электрический пробой диодов шоттки // Труды VIII Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы», Ульяновск, 2006,
4. Асланова А.Р. Температурной зависимости деградации вольтамперной характеристики диодов Шоттки // 9 Международная Научно-Техническая Конференция "Таганрог, "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники, 2006, с.176
5. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Şottki diodunun potensial çərərinin hündürlüyünün metalin təbiətindən asılılığı // IV Республиканской Научной Конфер."Актуальные проблемы физики", Баку, 2006, s.132
6. Асланова А.Р., Гаджиев З.И. Связь между температурными зависимостями высоты барьера и коэффициента неидеальности диода Шоттки // АМЕА, Физика, 2007, т. XIII, № 1-2, сс.324-326
7. Асланова А.Р. Температурные зависимости действующей высоты барьера реального диода Шоттки // Труды IX Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы», Ульяновск, 2007, с.198
8. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Зависимости эмиссионных параметров диодов Шоттки от полярности напряжения // АМЕА, Физика, 2007, т. XIII, № 4, сс.141-143
9. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Температурные особенности деградация вольтамперной характеристики диода Шоттки // Вестник Бакинского Университета, серия физ.мат.наук, 2007, №4.с.196-202
10. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Зависимость напряжения пробоя диода Шоттки от геометрического размера контакта // Тезис докл. XX Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва, 2008, с.196-197
11. Асланова А.Р. Расхождение токов насыщения реального диода Шоттки в прямом и обратном направлениях // Труды X Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы», Ульяновск, 2008
12. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Behaviour of temperature dependencies of barrier height and factor non-ideality of schottky diode // Prosc. Secand International Confrens Physics Techn. Energy, Turkey, 2008, pp.33-36
13. Асланова А.Р., Еганех М.А. Исследование эмиссионной неоднородности диодов Шоттки АСМ методом //Тезисы докл. XXII Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва, 2012, с.325-326
14. Исмаилов Т.Г., Асланова А.Р. Зависимости электрофизических параметров перехода металл - кремний от размеров контактной поверхности // Jurnal of Qafqaz University, Physics, 2014, v.2,n.2, pp.161-165
15. Ismailov T.H., Aslanova A.R. Influence of Peripheral Effects on the Electro Physical Properties of Schottky Diodes // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 2015, v.5, n.2, pp.1-7
16. Ismailov T.H., Aslanova A.R. Electrophysical properties of Schottky diodes with inhomogeneous contact surface // J. Supperlattices and Microstructures, 2016, v.90, pp.68-76
17. Mamedov R.K., Aslanova A.R. Additional electric field in real trench MOS barrier Schottky diode // J. Supperlattices and Microstructures, 2016, v.92, pp.1-9
18. Məmmədov R.Q., Aslanova Ə.R. Kontakt səthinin məhdudluğu ilə yaranan əlavə elektrik sahəsinin Şottki diodunda cərəyan axinına təsiri, İV İternational Scientific conference of young researchers, Baku, QU, 2016, p.65-66
19. Mamedov R.K., Aslanova A.R. Alternative current source based Schottky contact with additional electric field // J. Supperlattices and Microstructures, 2017, v.107, pp.28-37
20. Мамедов Р.К., Асланова А.Р., Электродвижущая сила контакта Шоттки с дополнительным электрическим полем, Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2017, № 1, с.75-77
21. Mamedov R.K., Aslanova A.R. Features of current-voltage characteristic of nonequilibrium trench MOS barrier Schottky diode // J. Supperlattices and Microstructures, 2018, v.118, pp.298-307